

平成 28 年度 TIA 連携プログラム探索推進事業「かけはし」
「ダイヤモンド電子デバイス実用化のための調査研究」ワークショップ

目的：

ダイヤモンド電子デバイス実用化のために必要な技術課題を議論し、その解決のため、TIA を中心とした共同研究を加速し、日本のダイヤモンド研究の体制作りのきっかけとする。

日時：2016 年 8 月 10 日（水曜日）

場所：産総研第 2 事業所第 6 会議室（2-12 棟 2 階）

9:30 AM - 9:35 AM

奥村元（産総研）

挨拶

9:35 AM - 9:50 AM

山崎聡（産総研）

本ワークショップの目的

9:50 AM - 10:30 AM

牧野俊晴（産総研）

ダイヤモンド電子デバイスの現状と問題点

10:30 AM - 11:10 AM

川波靖彦（安川電機）

ユーザの立場からのダイヤモンドパワーデバイスへの要望と期待

11:10 AM - 11:40 AM

田中真伸（KEK）

量子ビーム分野におけるダイヤモンド応用

ダイヤモンド結晶成長

1:00 PM - 1:40 PM

小泉聡（物材機構）

ダイヤモンド薄膜成長の基礎と半導体ドーピング

1:40 PM - 2:20 AM

山田英明（産総研）

ダイヤモンド単結晶基板開発

ダイヤモンド結晶構造評価

2:20 AM – 2:45 PM

加藤有香子 (産総研)

ダイヤモンド単結晶の欠陥構造

2:45 PM – 3:15 PM 休憩

3:15 PM – 3:40 PM

上殿明 (筑波大学)

陽電子消滅技術とダイヤモンド薄膜欠陥構造

3:40 PM – 4:05 PM

梅田享英 (筑波大学)

ダイヤモンド欠陥構造と、ESR、EDMR でできること。

ダイヤモンドプロセス技術

4:05 PM – 4:30 PM 八井崇 (東大)

近接場光表面平坦化技術とダイヤモンド表面制御技術

4:30 PM – 4:55 PM 山部紀久夫 (筑波大学)

電子デバイスにおける MOS 界面の重要性と制御技術

4:55 PM – 5:15 PM 全体議論

5:30 PM 懇親会

参加費：無料

懇親会費：2000 円 (予定) 簡単に所内で行う予定です。

会場の広さ確認と懇親会準備のため、現時点で参加希望される方、また、懇親会参加希望の方は

三上舞子 <mikami-maiko@aist.go.jp>

山崎聡 <s-yamasaki@aist.go.jp>

までご連絡ください。